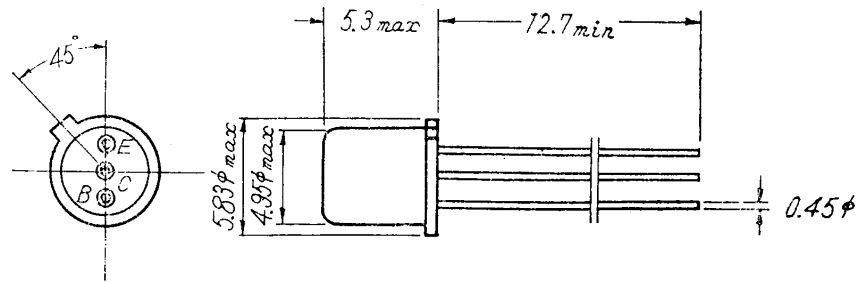
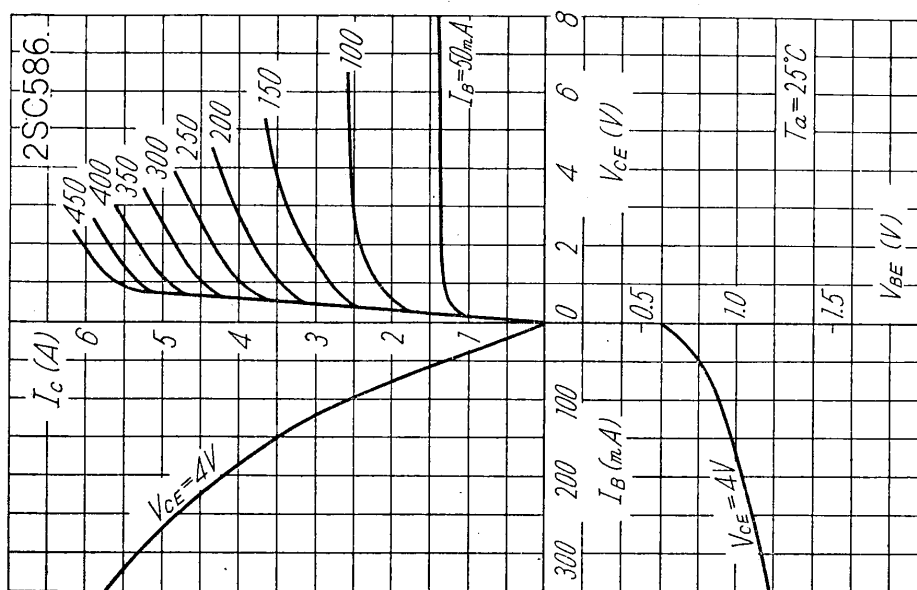


T-16



〔第1図〕 エミッタ接地静特性



2SC645

シリコン・エピタキシャル・プレナ型, 高周波増幅, 発振, 混合

2SC645 はシリコンNPNエピタキシャル・プレナ型トランジスタで, 高周波回路全般に適します。

外形 T-16

絶対最大定格 (周囲温度 25°C)

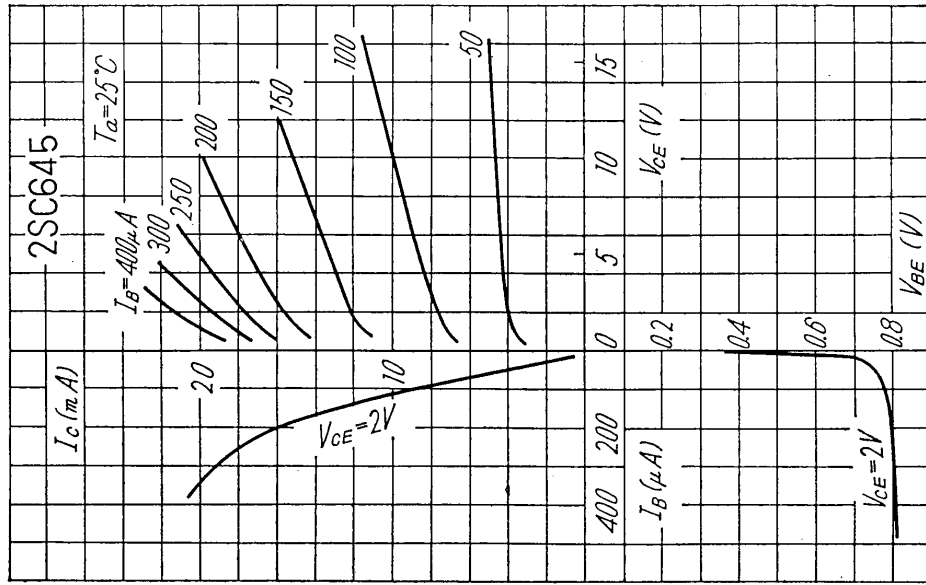
コレクタ・ベース電圧	V_{CBO}	最大	30	V
エミッタ・ベース電圧	V_{EBO}	最大	5	V
コレクタ電流	I_C	最大	30	mA
コレクタ損失	P_C	最大	140	mW
ジャンクション温度	T_j	最大	175	°C
保存温度	T_{stg}		-55~175	°C

電気的特性 (周囲温度 25°C)

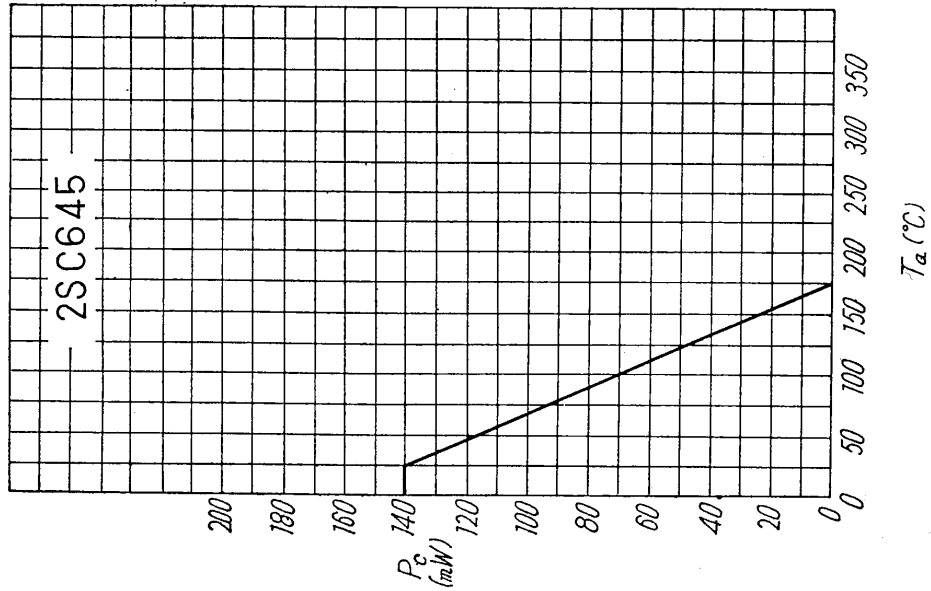
	条件	最小	標準	最大	
コレクタ遮断電流	I_{CBO}	1		1	μA
直流電流増幅率	h_{FE}	2	40	100	300
利得帯域幅	f_T	3	150		Mc
帰還容量	C_{re}	4		1.2	pF
帰還インピーダンス	$ z_{rb} $	4		50	Ω

- 条件
1. $V_{CB} = 10V$
 2. $V_{CB} = 10V, I_C = 1mA$
 3. $V_{CB} = 10V, I_C = 1mA$
 4. $V_{CB} = 10V, -I_E = 1mA$

〔第1図〕エミッタ接地静特性



〔第2図〕許容コレクタ損失



〔第3図〕直流電流増幅率電流特性

